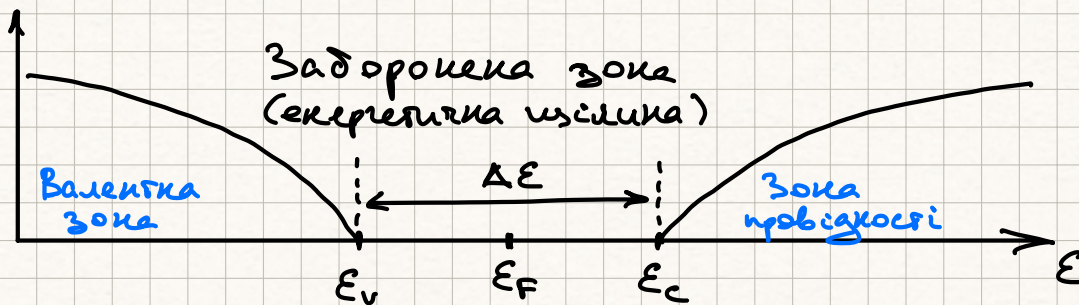


# Практичне заняття №2

## Задача №1.



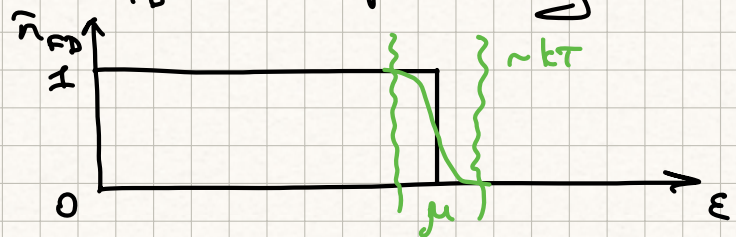
- (а) Як перше наближення, нехай густина станів біля дна зони провідності буде такою ж, як для вільного Фермі-газу:  $g(\epsilon) = g_0 \sqrt{\epsilon - \epsilon_c}$ , де  $g_0 = \frac{3N}{2\epsilon_F^{3/2}} = \frac{\pi(8m)^{3/2}}{2h^3} V = \text{const.}$  Ми будемо моделювати густину станів біля вершини валентної зони як її дзеркальне відображення. Тобто, тому в такому випадку хім. потенціал має бути рівно посередині між двома зонами.

$$g(\epsilon) \bar{n}_{FD}(\epsilon) ; \quad g(\epsilon) \text{ симетрична відносно } \epsilon = \epsilon_F$$

$$\bar{n}_{FD}(\epsilon) \text{ симетрична відносно } \epsilon = \mu$$

$$\bar{n}_{FD} = \frac{1}{1 + e^{\frac{\epsilon - \mu}{k_B T}}} ;$$

$$\mu = \epsilon_F (1 + \dots)$$



- (б) Вивести кількість електронів у зоні провідності як ф-цію температури  $T$  і ширини забороненої зони  $\Delta E$ , якщо  $\Delta E \gg kT$ .

$$N_c = \int_{\epsilon_c}^{\infty} g(\epsilon) \bar{n}_{FD}(\epsilon) d\epsilon = g_0 \int_{\epsilon_c}^{\infty} \sqrt{\epsilon - \epsilon_c} \frac{1}{e^{\frac{(\epsilon - \epsilon_F)}{k_B T}} + 1} d\epsilon =$$

$$= g_0 \int_{\epsilon_c}^{\infty} \sqrt{\epsilon - \epsilon_c} e^{-\frac{(\epsilon - \epsilon_c)}{k_B T}} \cdot e^{-\frac{(\epsilon_c - \epsilon_F)}{k_B T}} d\epsilon =$$

$$= g_0 e^{-\frac{(\epsilon_c - \epsilon_F)}{k_B T}} \cdot (k_B T)^{3/2} \int_0^{\infty} \sqrt{x} e^{-x} dx ;$$

$$= \sqrt{\pi}/2$$

$$N_c = \frac{\pi (8m)^{3/2}}{2h^3} V (k_B T)^{3/2} \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{2} e^{-(E_c - E_F)/k_B T} = \frac{2V}{\lambda^3} e^{-\frac{\Delta E}{2k_B T}};$$

(с) Для кремнію (Si) при кімнатній  $T$ -рі  $\Delta E \approx 1.1$  еВ.

Обчислити, скільки у нього буде електронів в зоні провідності на  $1 \text{ см}^3$ ? Як це співвідноситься з аналогічною величиною для міді?

$$k_B T \approx 0.026 \text{ еВ} \Rightarrow$$

$$e^{-\Delta E/2k_B T} = \exp\left(-\frac{1.11 \text{ еВ}}{2 \cdot 0.026 \text{ еВ}}\right) = e^{-21.3} = 5.4 \cdot 10^{-10};$$

$$\lambda^3 = \left( \frac{(6.63 \cdot 10^{-34} \text{ Дж} \cdot \text{с})^2}{2\pi (9.11 \cdot 10^{-31} \text{ кг}) \cdot (1.38 \cdot 10^{-23} \text{ Дж/К}) \cdot (300 \text{ К})} \right)^{3/2} = 8.0 \cdot 10^{-26} \text{ м}^3;$$

$$\frac{N_c}{V} = \frac{2 \cdot 5.4 \cdot 10^{-10}}{8.0 \cdot 10^{-26} \text{ м}^3} = 1.3 \cdot 10^{16} \text{ м}^{-3} = 1.3 \cdot 10^{10} \text{ см}^{-3};$$

$$\text{Для міді (Cu): } 8.5 \cdot 10^{28} \text{ м}^{-3} = 8.5 \cdot 10^{22} \text{ см}^{-3}.$$

(d) Пояскіть, чому напівпровідник краще проводить струм при високих  $T$ -рах. Підтвердіть це числами.

Піднімаємо  $T$ -ру від 300К до 350К.

$$\text{Для } \lambda^3: (350/300)^{3/2} \approx 1.26.$$

$$e^{-\Delta E/2k_B T} = \exp\left(-\frac{1.11 \text{ еВ}}{2 \cdot (8.62 \cdot 10^{-5} \text{ еВ/К}) \cdot (350 \text{ К})}\right) = e^{-18.4} = 1.0 \cdot 10^{-8};$$

- більше у 19 разів ніж для  $T=300\text{К}$ .

$N_c/V$  збільшиться більше ніж у 20 разів.

(e) Грудь кажучи, наскільки широко має бути енергетична щільність, щоб матеріал вважався ізолятором, а не напівпровідником?


$$\text{Для } \Delta E = 3 \text{ еВ: } e^{-\Delta E/2k_B T} = \exp\left(-\frac{3 \text{ еВ}}{2 \cdot 0.026 \text{ еВ}}\right) = e^{-57.7} = 9 \cdot 10^{-26};$$

$$N_c/V = \frac{2 \cdot (9 \cdot 10^{-26})}{8.0 \cdot 10^{-26} \text{ м}^3} \approx 2 \text{ м}^3.$$

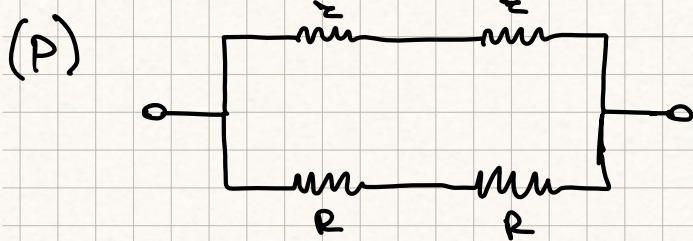


# Практичне заняття №5

Задача №5.1 Припускаючи, що тунельні резистори  $R_1$  та  $R_2$ , що підключені паралельно, дають сумарний опір  $KR_1R_2$ , де  $K = \text{const}$ , показати, що TMR дорівнює  $2P^2/(1-P^2)$ .

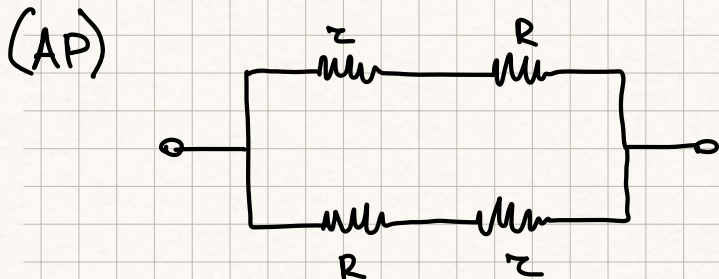
Було:   $R_1 + R_2$

Тепер:   $KR_1R_2$



$$R_P = Kz^2 \parallel KR^2 = \frac{\cancel{K}z^2 \cdot \cancel{K}R^2}{\cancel{K}z^2 + \cancel{K}R^2};$$

$$R_P = \frac{Kz^2R^2}{z^2 + R^2};$$



$$R_{AP} = KzR \parallel KzR = \frac{\cancel{K}zR \cdot \cancel{K}zR}{\cancel{K}zR + \cancel{K}zR};$$

$$R_{AP} = \frac{KzR}{2};$$

$$TMR = \frac{R_{AP} - R_P}{R_P} = \frac{R_{AP}}{R_P} - 1;$$

$$\frac{R_{AP}}{R_P} = \frac{\cancel{K}zR}{z} \cdot \frac{z^2 + R^2}{\cancel{K}z^2R^2} = \frac{z^2 + R^2}{2zR} = \frac{(R+z)^2 + (R-z)^2}{(R+z)^2 - (R-z)^2};$$

$$P = \frac{R-z}{R+z} \quad \text{поляризація магніта}$$

$$\frac{R_{AP}}{R_P} = \frac{\left(\frac{R+z}{R+z}\right)^2 + \left(\frac{R-z}{R+z}\right)^2}{\left(\frac{R+z}{R+z}\right)^2 - \left(\frac{R-z}{R+z}\right)^2} = \frac{1+P^2}{1-P^2};$$

$$TMR = \frac{1+P^2}{1-P^2} - 1 = \frac{\cancel{1}+P^2 - \cancel{1}+P^2}{1-P^2} = \frac{2P^2}{1-P^2}; \quad TMR = \frac{2P^2}{1-P^2};$$

Задача 5.2 Розглянути двовимірні провідники з трьома різними відношеннями між енергією та сингулярною.

а)  $E = E_c + \frac{p^2}{2m}$ ; б)  $E = E_c + v_0 p$ ; в)  $E = \sqrt{E_c^2 + v_0^2 p^2}$ ;

У кожному із цих випадків знайти  $\rho$ -ці  $N(E)$  та  $D(E)$  і перевірити, чи задовільняється умова:  $D v p = N d$ , де  $d=2$  - розмірність системи.

Розглянемо випадок (в):

$$\begin{cases} E(p) = \sqrt{E_c^2 + v_0^2 p^2}; & E^2 = E_c^2 + v_0^2 p^2; \\ N(p) = \pi W L \left(\frac{p}{h}\right)^2; & p^2 = \frac{E^2 - E_c^2}{v_0^2}; \end{cases}$$

$$N(E) = \pi W L \frac{E^2 - E_c^2}{h^2 v_0^2} = \frac{\pi W L}{h^2} \frac{E^2 - E_c^2}{v_0^2};$$

$$D(E) = \frac{dN(E)}{dE} = \frac{\pi W L}{h^2} \frac{2E}{v_0^2} = \frac{2\pi W L E}{h^2 v_0^2};$$

$$D v p = N d ?$$

$$v(E) = \frac{dE}{dp} = \frac{d}{dp} \sqrt{E_c^2 + v_0^2 p^2} = \frac{1}{2} (E_c^2 + v_0^2 p^2)^{-1/2} \cdot 2 p v_0^2;$$

$$v(E) = \frac{v_0^2 p}{E};$$

$$D(E) v(E) p = \frac{2\pi W L E}{h^2 v_0^2} \cdot \frac{v_0^2 p}{E} \cdot p = \frac{2\pi W L}{h^2} p^2 = 2\pi W L \left(\frac{p}{h}\right)^2;$$

$$N(p) \cdot d = 2 N(p) = 2\pi W L \left(\frac{p}{h}\right)^2; \quad D v p = N d;$$

Задача 5.3 Розглянути двовимірні провідники з трьома різними відношеннями між енергією та сингулярною

а)  $E = E_c + \frac{p^2}{2m}$ ; б)  $E = E_c + v_0 p$ ; в)  $E = \sqrt{E_c^2 + v_0^2 p^2}$ .

У кожному із цих випадків знайти кількість мод за формулою  $M(E) = \frac{h D v}{2L} \left\{ 1, \left(\frac{2}{\pi}\right), \frac{1}{2} \right\}$  та показати,



що воно співпадає із формулою:  $M(E) = \left\{ 1, 2 \frac{W}{h/p}, \pi \frac{A}{(h/p)^2} \right\}$ .

Розглянемо випадок (с):

$$M(E) = \frac{\hbar D U}{2L} \cdot \frac{2}{\pi} = \frac{\hbar}{\pi L} D(E) U(E);$$

Для  $D(E)$  та  $U(E)$  отримані вище:

$$D(E) = \frac{2\pi W L E}{\hbar^2 U_0^2}; \quad U(E) = \frac{U_0^2 P}{E};$$

$$M(E) = \frac{\hbar}{\pi L} \cdot \frac{2\pi W L E}{\hbar^2 U_0^2} \cdot \frac{U_0^2 P}{E} = 2W \frac{P}{\hbar} = 2 \frac{W}{h/p};$$

З фізичної точки зору:  $M(E) = \text{Int} \left\{ 2 \frac{W}{h/p} \right\}$ .

## Практичне заняття №6

### Задача №6.1 Спінові хвилі у ферромагнетик.

При  $T=0$  :  $M \sim 2\mu_B N$ .

При  $T \neq 0 \rightarrow$  збудження у формі спінових хвиль.

Магнони - квазічастинки, що описують спінові хвилі.

Кожен магنون зменшує повний спін системи на  $\hbar = h/2\pi$ , тобто зменшує намагніченість на  $\sim 2\mu_B$ . Але, для магнонів  $\omega \sim (1/\lambda)^2$  :  $E = \hbar\omega = \hbar\omega$ ,  $p = \hbar/\lambda \Rightarrow E \sim p^2$ . Тобто, для магнонів :  $E = p^2/2m^*$ .

Точність величина  $m^*$  пов'язана із спин-спінною взаємодією та мішанною відстакою.

Для заліза (Fe) :  $m^* = 1.24 \cdot 10^{-29}$  кг, тобто  $m^* \approx 14 m_e$ .

У магнона є лише одна можливість поляризації.

а) Показати, що при низьких  $T$ -рах кількість магнонів на од. об'єма у 3D ферромагнетик дорівнює

$$\frac{N_m}{V} = 2\pi \left( \frac{2m^* k_B T}{\hbar^2} \right)^{3/2} \int_0^\infty \frac{\sqrt{x}}{e^x - 1} dx. \quad \text{Означити інтеграл.}$$

$$N_m = \sum_{n_x, n_y, n_z} \frac{1}{e^{E/k_B T} - 1}; \quad E = p^2/2m^*; \quad p = \frac{\hbar}{\lambda} = \frac{\hbar n}{2L}.$$

$$n = \sqrt{n_x^2 + n_y^2 + n_z^2}.$$

$$\Rightarrow N_m = \int \frac{1}{e^{E/k_B T} - 1} d^3 n = \frac{\pi}{2} \int_0^\infty \frac{n^2 dn}{e^{E/k_B T} - 1};$$

$$x = \frac{E}{k_B T}; \quad x = \frac{p^2}{2m^* k_B T} = \frac{\hbar^2 n^2}{8m^* L^2 k_B T};$$

$$n = \sqrt{\frac{8m^* L^2 k_B T x}{\hbar^2}}; \quad dn = \sqrt{\frac{2m^* L^2 k_B T}{\hbar^2}} \cdot \frac{dx}{\sqrt{x}};$$

$$N_m = \frac{2\pi}{2} \cdot \frac{8m^* L^2 k_B T}{\hbar^2} \cdot \sqrt{\frac{2m^* L^2 k_B T}{\hbar^2}} \int_0^\infty \frac{\sqrt{x} dx}{e^x - 1};$$



$$\frac{N_m}{V} = 2\pi \left( \frac{2m^*k_B T}{h^2} \right)^{3/2} \int_0^\infty \frac{\sqrt{x}}{e^x - 1} dx ; \quad L^3 = V ; \quad = 2.315$$

б) Обчислити відношення зменшення намагніченості,  $\frac{M(0) - M(T)}{M(0)}$ , як ф-цією від  $\left(\frac{T}{T_0}\right)$ .

Якщо при  $T=0$ :  $M(0) = 2\mu_B N$ , і кожен магнетон зменшує це значення на  $2\mu_B \Rightarrow$

$$\frac{M(T)}{M(0)} = \frac{2\mu_B N_m}{2\mu_B N} = \frac{N_m}{N} = 2\pi (2.315) \frac{V}{N} \left( \frac{2m^*k_B T}{h^2} \right)^{3/2} \Rightarrow$$

$$\frac{N_m}{N} = \left( \frac{T}{T_0} \right)^{3/2}, \quad T_0 = \frac{h^2}{2m^*k_B} \left( \frac{N}{V} \right)^{2/3} \frac{1}{(2\pi \cdot 2.315)^{2/3}} ;$$

$$T_0 = \frac{0.0839 \cdot h^2}{m^*k_B} \left( \frac{N}{V} \right)^{2/3} ;$$

$$\frac{M(0) - M(T)}{M(0)} = 1 - \frac{M(T)}{M(0)} = 1 - \left( \frac{T}{T_0} \right)^{3/2} ;$$

Обчислимо  $T_0$  для заліза (Fe):  $m^* = 1.24 \cdot 10^{-29} \text{ кг} ;$

Об'єм одного моль Fe:  $V = 7.11 \cdot 10^{-6} \text{ м}^3$  (можна це обчислити)

$$T_0 = \frac{(0.0839) \cdot (6.63 \cdot 10^{-34} \text{ Дж} \cdot \text{с})^2}{(1.24 \cdot 10^{-29} \text{ кг}) \cdot (1.38 \cdot 10^{-23} \text{ Дж/К})} \cdot \left( \frac{6.02 \cdot 10^{23}}{7.11 \cdot 10^{-6} \text{ м}^3} \right)^{2/3} \Rightarrow$$

$$T_0(\text{Fe}) = 4150 \text{ К}.$$

с) Обчислити теплоємність, пов'язану із маскованими збудженнями для ферромагнетика при низьких  $T$ -рах.

$$C = \frac{\partial U}{\partial T} ; \quad U(T) - ?$$

$$U = \sum_{n_x, n_y, n_z} \frac{\epsilon}{e^{\epsilon/k_B T} - 1} = \frac{\pi}{2} \int_0^\infty \frac{\epsilon n^2}{e^{\epsilon/k_B T} - 1} dn ; \quad x = \frac{\epsilon}{k_B T} ;$$

$$U = 2\pi V \left( \frac{2m^*k_B T}{h^2} \right)^{3/2} k_B T \int_0^\infty \frac{x^{3/2} dx}{e^x - 1} ; \quad = 1.783$$

$$U = 2\pi (1.783) \cdot V k_B \left( \frac{2m^*k_B}{h^2} \right)^{3/2} \cdot T^{5/2} ;$$

$$U = 31.69 \cdot k_B V \left( \frac{m^* k_B}{h^2} \right)^{3/2} \cdot T^{5/2} ;$$

$$\frac{C_V}{N k_B} = \frac{1}{N k_B} \frac{\partial U}{\partial T} = 31.69 \cdot \frac{5}{2} \frac{V}{N} \left( \frac{m^* k_B}{h^2} \right)^{3/2} T^{3/2} ;$$

$$\frac{C_V}{N k_B} = \left( \frac{T}{T_1} \right)^{3/2} ; \quad T_1 = \frac{h^2}{m^* k_B} \left( \frac{N}{V} \right)^{2/3} \cdot \left( \frac{2}{5 \cdot 31.69} \right)^{2/3} ;$$

$$T_1 = \frac{T_0}{0.0839} \cdot \left( \frac{2}{5 \cdot 31.69} \right)^{2/3} = (0.646) \cdot T_0 .$$

$$\text{Fe : } T_1 = 2680 \text{ K} .$$

$$\left( \frac{T}{T_1} \right)^{3/2} = \frac{12\pi^4}{5} \left( \frac{T}{T_D} \right)^3 ;$$

$$T = \left( \frac{5}{12\pi^4} \right)^{2/3} \cdot \frac{T_D^2}{T_1} = 0.0264 \cdot \frac{(470 \text{ K})^2}{2680 \text{ K}} = 2.17 \text{ K} .$$